

**III Российское совещание
по росту
кристаллов и пленок и исследо-
вание их физических свойств и
структурного совершенства
КРЕМНИЙ-2006**

04-06 июля 2006г.

Красноярск

III российское совещание по росту кристаллов и пленок кремния и исследование их физических свойств и структурного совершенства «Кремний-2006», которое будет проводиться в г. Красноярске 04-06 июля 2006 г. (на базе ИФ СО РАН), продолжает традицию, заложенную предыдущими совещаниями, которые проводились в г. Новосибирске (1969, 1973, 1977, 1988, 2002 гг), и в 2004 г. в г. Иркутске и которые были посвящены природе и механизмам образования дефектов, установлению связи между условиями и механизмами роста полупроводниковых кристаллов и эпитаксиальных слоев, процессам легирования полупроводников. Совещание ставит целью обсуждение существующих в настоящее время проблем в области роста слитков полупроводникового кремния и эпитаксиальных слоев и в создании низкоразмерных и новых приборных структур. Предполагается собрать вместе специалистов, работающих в различных областях кремниевой тематики, и, обсудить современное состояние проблемы и пути развития кремниевой технологии.

**СОВЕЩАНИЕ ПРОВОДИТСЯ
ПРИ СОДЕЙСТВИИ:**

- РФФИ;
- Минобрнауки;
- Администрации Красноярского края;
- Красноярского ГХК;
- ФГУП «Красмаш»
- Завода «Цветные металлы»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Процессы роста из расплава методами зонной плавки и Чохральского.
2. Эпитаксиальные структуры, низкоразмерные системы на основе кремния.
3. Структуры кремний-на-изоляторе.
4. Дефекты и примеси, ионная имплантация, ядерное легирование.
5. Микроструктурные, аморфные и пористые слои.
6. Новые приборные структуры на основе объемного материала и наноструктур.
7. Методы и аппаратура для роста и исследования кремния.

ОРГАНИЗАТОР:

Институт физики им. Л.В.Киренского

Программный комитет:

Председатель – Кузнецов Ф.А ИНХ СО РАН, Новосибирск
Сопредседатель – Асеев А.Л., ИФП СО РАН, Новосибирск
Беляков Г.П., СибГАУ, Красноярск
Бердников В.С., ИФТ СО РАН, Новосибирск
Владимиров В.М., КНЦ СО РАН, Красноярск
Вяткин А.П., ИПТМ РАН, Москва
Грибов Б.Г., ВНИОЧМ, Зеленоград, Московская обл.
Дашевский М.Я., МИСиС, Москва
Двуреченский А.В., ИФП СО РАН, Новосибирск
Елютин А.В., Гиредмет, Москва
Каменский И.М., Минатом РФ, Москва
Колмыков В.А. «Красмаш», Красноярск
Кобелева С.П., МИСиС, Москва
Кравцов В.В., ГУЦМиЗ, Красноярск
Красильник З.Ф., ИФМ РАН, Н.Новгород
Красников Г.Я., НИИМЭ, Москва
Лебедев В.А., Минатом РФ, Москва
Мильвидский М.Г., Гиредмет, Москва
Неизвестный А.Г., ИФП СО РАН, Новосибирск
Непомнящих А.И., ИГХ СО РАН, Иркутск
Орликовский А.А., ФТИ РАН, Москва
Подлесный С.А., КГТУ, Красноярск
Проворов А.С., КрасГУ, Красноярск
Пчеляков О.П., ИФП СО РАН, Новосибирск
Ревенко Ю.А., ГХК, Железногорск
Сорокин Л.М., ФТИ РАН, С.-Петербург
Тихов И.В., «Красцветмет», Красноярск
Харченко В.А., Гиредмет, Москва

Организационный комитет:

Председатель – академик РАН
В.Ф.Шабанов, ИФ СО РАН, Красноярск
Сопредседатель – *А.А.Асеев*, ИФП СО
РАН, Новосибирск

Зам. председателя - *Акбулатов Э.Ш.*,
Администрация Красноярского края,
Красноярск

Зам. председателя - *В.М.Владимиров*,
КНЦ СО РАН, Красноярск

Уч. секретарь – *Г.Л.Границкая*, КНЦ СО
РАН, Красноярск

Члены оргкомитета:

Борисов Игорь Анатольевич ЗАО «Крем-
ний», Шелехов

Бузунов А.И. «Красцветмет» им. Гули-
дова, Красноярск

Дашевский М.Я. МИСИС, Москва

Двуреченский А.В. ИФП СО РАН, Новоси-
бирск

Золотайко А.В. СУАЛ-Кремний-Урал

Калипин В.В. ИФП, Новосибирск

Логинов Ю.Ю. КГУ, Красноярск

Непомнящих А.И. ИГХ СО РАН, Иркутск

Терехин Н.А. «Красмаш», Красноярск

Шагаров Б.А. ГХК, Железнодорожск

Шепов В.Н., СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН,
Красноярск

Регистрационная форма

Можно переслать регистрационную форму на
адрес Оргкомитета по электронной почте:

silicon06@mail.ru

Представление тезисов докла- дов

До 30 марта 2006г. необходимо представить
тезисы докладов по электронной почте в ад-
рес Оргкомитета совещания.

Адрес оргкомитета совещания

Границкая Галина Львовна
КНЦ СО РАН

Академгородок 50

660036, Красноярск, Россия

Тел.: (3912) 494494

Факс: (3912) 439765

e-mail: silicon06@mail.ru

Оформление тезисов

Объем тезисов не более 1 страницы формата
А4, включая встроенные в текст рисунки; поля
– верхнее и нижнее 2 см, левое и правое –
3см; интервал 1.5;

редактор Word для Windows 6, 7;

шрифты Times New Roman: текст – 12 нор-
мальный, прямой; заголовок – 14 жирный;
фамилии авторов, название организаций, ад-
ресные данные, включая электронный адрес,
телефон и факс – 12 жирный;

фамилия докладчика подчеркнута;

ссылки в прямых скобках [], список литерату-
ры не озаглавляется.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Ф.И.О. _____

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ _____

ДОЛЖНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ _____

АДРЕС _____

ТЕЛЕФОН _____ ФАКС _____

E-mail _____

Я планирую принять участие в работе конференции:

[] без представления доклада

[] ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ
ДОКЛАДА _____

ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ _____